

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/366

Devices

2N3498	2N3499	2N3500	2N3501
2N3498L	2N3499L	2N3500L	2N3501L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3498* 2N3499*	2N3500* 2N3501*	Unit
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	100	150	Vdc
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	100	150	Vdc
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	6.0	6.0	Vdc
Collector Current	I _C	500	300	mAdc
Total Power Dissipation	P _T	@ T _A = 25°C ⁽¹⁾	1.0	W
		@ T _C = 25°C ⁽²⁾	5.0	W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T _J , T _{stg}	-55 to +200		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance: Junction-to-Case	R _{θJC}	35	°C/W
Junction-to-Ambient	R _{θJA}	175	

*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 W/°C for T_A > 25°C

2) Derate linearly 28.6 W/°C for T_C > 25°C



TO-5*
2N3498L, 2N3499L
2N3500L, 2N3501L



TO-39* (TO-205AD)
2N3498, 2N3499
2N3500, 2N3501

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage I _C = 10 mAdc	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	V _{(BR)CEO}	100 150	Vdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 50 Vdc V _{CB} = 75 Vdc V _{CB} = 100 Vdc V _{CB} = 150 Vdc	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501 2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	I _{CBO}	50 50 10 10	ηAdc ηAdc μAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current V _{EB} = 4.0 Vdc V _{EB} = 6.0 Vdc		I _{EBO}	25 10	ηAdc μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics		Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾					
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 0.1 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501	h_{FE}	20 35		
$I_C = 1.0 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		25 50		
$I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		35 75		
$I_C = 150 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		40 100	120 300	
$I_C = 300 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3500 2N3501		15 20		
$I_C = 500 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3498 2N3499		15 20		
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$	All Types		$V_{CE(sat)}$		0.2
$I_C = 300 \text{ mAdc}, I_B = 30 \text{ mAdc}$	2N3498, 2N349	0.6			
$I_C = 150 \text{ mAdc}, I_B = 15 \text{ mAdc}$	2N3500, 2N3501	0.4			
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$	All Types	$V_{BE(sat)}$		0.8	Vdc
$I_C = 300 \text{ mAdc}, I_B = 30 \text{ mAdc}$	2N3498, 2N3499		1.4		
$I_C = 150 \text{ mAdc}, I_B = 15 \text{ mAdc}$	2N3500, 2N3501		1.2		

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio, Magnitude $I_C = 20 \text{ mAdc}, V_{CE} = 20 \text{ Vdc}, f = 100 \text{ MHz}$		$ h_{fe} $	1.5	8.0	
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ Vdc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	C_{obo}		10 8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5 \text{ Vdc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{ibo}		80	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time $V_{EB} = 5 \text{ Vdc}; I_C = 150 \text{ mAdc}; I_{B1} = 15 \text{ mAdc}$		t_{on}		115	ns
Turn-Off Time $I_C = 150 \text{ mAdc}; I_{B1} = I_{B2} = -15 \text{ mAdc}$		t_{off}		1150	ns

SAFE OPERATING AREA

DC Tests					
$T_C = +25^\circ\text{C}, t_r \geq 10 \text{ ns}; 1 \text{ Cycle}, t = 1.0 \text{ s}$					
Test 1					
$V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, I_C = 500 \text{ mAdc}$	2N3498, 2N3499				
$V_{CE} = 16.67 \text{ Vdc}, I_C = 300 \text{ mAdc}$	2N3500, 2N3501				
Test 2					
$V_{CE} = 50 \text{ Vdc}, I_C = 100 \text{ mAdc}$	All Types				
Test 3					
$V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, I_C = 40 \text{ mAdc}$	All Types				
Clamped Switching					
$T_A = +25^\circ\text{C}$					
Test 1					
$I_B = 85 \text{ mAdc}, I_C = 500 \text{ mAdc}$	2N3498, 2N3499				
$I_B = 50 \text{ mAdc}, I_C = 300 \text{ mAdc}$	2N3500, 2N3501				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300µs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331